

a 2017 0092

Invenția se referă la tehnologia semiconductorilor și poate fi utilizată, în special, în convertoarele fotovoltaice. Procedeul de majorare a eficienței celulelor fotovoltaice pe baza p⁺InP-p⁺InP-n⁺CdS include creșterea stratului p⁺InP pe un substrat, executat în formă de plachetă din p⁺InP cu orientarea cristalografică (100), dezorientarea de 3...5° în direcția (110) și concentrația purtătorilor de sarcină de 10¹⁸ cm⁻³, depunerea, pe partea frontală a plachetei, prin metoda volumului cuaziînchis a stratului n⁺CdS, depunerea pe partea posterioară a unui contact ohmic din Ag+Zn, tratarea termică a lui la temperatura de 450°C, depunerea unui contact ohmic din In pe stratul din n⁺CdS, tratarea termică a lui la temperatura de 250°C și depunerea prin metoda pulverizării, la temperatura de 300°C, a unui strat antireflector de ZnO.

Revendicări: 1